

# 2SA839

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

○低周波電力増幅用 ○励振段電力増幅用

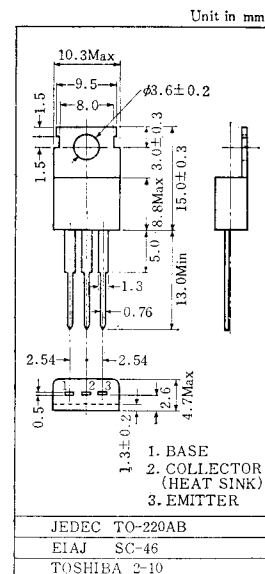
○ Audio Power Amplifier Applications

○ Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です： $V_{CEO} = -150V$
- 高出力 Hi-Fi Amp. の励振段に適します。
- 2SC1669 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1669

## 最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

| Characteristic                | Symbol    | Rating  | Unit       |
|-------------------------------|-----------|---------|------------|
| コレクタ・ベース間電圧                   | $V_{CBO}$ | -150    | V          |
| コレクタ・エミッタ間電圧                  | $V_{CEO}$ | -150    | V          |
| エミッタ・ベース間電圧                   | $V_{EBO}$ | -5      | V          |
| コレクタ電流                        | $I_C$     | -1.5    | A          |
| エミッタ電流                        | $I_E$     | 1.5     | A          |
| コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ ) | $P_C$     | 25      | W          |
| 接合温度                          | $T_j$     | 150     | $^\circ C$ |
| 保存温度                          | $T_{stg}$ | -55~150 | $^\circ C$ |



アクセサリはAC75を適用  
MOUNTING KIT NO. AC75

## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

| Characteristic | Symbol              | Condition                          | Min. | Typ. | Max. | Unit    |
|----------------|---------------------|------------------------------------|------|------|------|---------|
| コレクタシャ断電流      | $I_{CBO}$           | $V_{CB} = -100V, I_E = 0$          | —    | —    | -20  | $\mu A$ |
| エミッタシャ断電流      | $I_{EBO}$           | $V_{EB} = -5V, I_C = 0$            | —    | —    | -10  | $\mu A$ |
| コレクタ・エミッタ間降伏電圧 | $V_{(BR)CEO}$       | $I_C = -10mA, I_B = 0$             | -150 | —    | —    | V       |
| エミッタ・ベース間降伏電圧  | $V_{(BR)EBO}$       | $I_E = -1mA, I_C = 0$              | -5   | —    | —    | V       |
| 直流電流増幅率        | $h_{FE(1)}$<br>Note | $V_{CE} = -10V, I_C = -0.5A$       | 40   | —    | 240  |         |
|                | $h_{FE(2)}$         | $V_{CE} = -10V, I_C = -1A$         | 20   | —    | —    |         |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$       | $I_C = -500mA, I_B = -50mA$        | —    | —    | -1.5 | V       |
| ベース・エミッタ間電圧    | $V_{BE}$            | $V_{CE} = -10V, I_C = -0.5A$       | -0.7 | —    | -1.0 | V       |
| トランジション周波数     | $f_T$               | $V_{CE} = -10V, I_E = 0.5A$        | —    | 6    | —    | MHz     |
| コレクタ出力容量       | $C_{ob}$            | $V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$ | —    | 100  | —    | pF      |

Note ;  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SA839 is classified as follows.

| Classification | Min. | Max. |
|----------------|------|------|
| 2SA839—R       | 40   | 80   |
| 2SA839—O       | 70   | 140  |
| 2SA839—Y       | 120  | 240  |

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.